## ОСОБЕННОСТИ РЕЗОНАНСНОГО РАССЕЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН НА ЭЛЛИПСОИДАЛЬНОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ В ПРЯМОУГОЛЬНОМ ВОЛНОВОДЕ

## Н. И. Украинец, Н. А. Хижняк Харьков

Ранее [1, 2] проведены теоретические и экспериментальные исследования резонансного рассеяния электромагнитных волн на диэлектрической неоднородности сферической геометрии в прямо-

угольном волноводе. Зависимость величины коэффициентов отражения от частоты имеет резонансный характер. Показано, что наиболее узкий резонанс наблюдается в случае сферы, расположенной в центре волновода. Экспериментально исследовано расщепление резонанса, которое, как показывают расчеты, обусловлено влиянием стенок волновода на внутреннее поле в сфере. В настоящее время имеется полное теоретическое истолкование тонкой структуры резонансной кривой для этого случая.

Экспериментальное исследование рассеяния электромагнитных волн от диэлектрической неоднородности эллипсоидальной геометрии, проведенное при тех же условиях, что и для сферической неоднородности, показывает значительное расширение резонансной кривой и более сложную ее структуру [3]. Объяснение этому явлению можно искать в теории, однако теоретический анализ рассеяния волн на резонансных эллипсоидах еще не проведен. Чтобы выяснить физику самого явления, мы провели дополнительные экспериментальные исследования.

Исходные предпосылки основываются на следующих соображениях. В случае искусственных диэлектриков [4], образованных правильными решетками эллипсоидальных частиц, их дисперсия, анизотропия и прочие свойства могут быть обусловлены либо дисперсией (анизотропией) самих рассеивающих тел, либо дисперсией (анизотропией) пространственной решетки. В некотором смысле влияние рассеивающего тела может быть усилено или скомпенсировано геометрией пространственной решетки.

Действительно, при рассмотрении рассеяния волн на диэлектрическом теле в прямоугольном волноводе необходимо учитывать наличие стенок волновода, например, с помощью метода зеркальных изображений, что и приводит в конечном итоге к ситуации, имеющей место в искусственных диэлектриках. Рассеяние волн на одной неоднородности с учетом стенок в электродинамическом отношении эквивалентно рассеянию волн на решетке из этих неоднородностей в свободном пространстве. Можно поэтому ожидать, что анизотропию рассеяния и дисперсию резонансных свойств усиливают или ослабляют изменением положения сферы или эллипсоида в сечении волновода или же изменением геометрии самого рессеивающего тела.

Целью настоящей работы является систематическое экспериментальное исследование резонансного рассеяния волн на диэлектрическом эллипсоиде в прямоугольном волноводе в зависимости от его положения относительно стенок волновода и сравнение с аналогичным рассеянием на диэлектрической сфере в целях обнаружения усиления или ослабления дисперсионных свойств рассеяния в зависимости от положения тела и геометрии волновода.

Блок-схема измерений состояла из генератора сигналов, ферритового вентиля, измерительной линии, измерительной секции с исследуемой неоднородностью, согласованной нагрузки и индикатора. Измерительная секция представляет собой специально сконструированное устройство с микрометрическими винтами для перемещения неоднородности в волноводе. Вся измерительная установка выполнена на волноводе сечением  $10 \times 23$  мм. Эллипсоид вращения и сфера были изготовлены из одного и того же материала с  $\varepsilon = 151$ ,  $tg\delta = 0,002$ . Размеры эллипсоида: 2a = 10 мм,  $2\theta = 5$  мм, где a,  $\theta$  — большая и малая полуоси эллипсоида. Диаметр сферы равен меньшей оси эллипсоида вращения.



Рис. 1. Зависимость коэффициентов стоячих волн от длины рассеиваемой электромагнитной волны для диэлектрической сферы диаметром 5 мм:



Из рис. 1 видно, что для сферы, расположенной в геометрическом центре поперечного сечения волновода, резонанс очень узкий (кривая 1). Наблюдается лишь тонкое расщепление резонанса, обусловленное влиянием стенок волновода. При перемещении сферы к середине широкой стенки волновода полоса и коэффициенты стоячих волн (следовательно, и коэффициенты отражения) увеличиваются. Возникает также новый дополнительный резонанс электрического типа на длине волны  $\lambda = 35 \text{ мм}$  (кривая 2). Но аналогичное расширение резонансной полосы наблюдается [З] и при вращении диэлектрического эллипсоида, расположенного в геометрическом центре поперечного сечения волновода, вокруг осей волновода. Следовательно, сфера, размещенная посередине широкой стенки волновода, ведет себя подобно эллипсоиду.

При перемещении сферы из геометрического центра поперечного сечения волновода к середине узкой стенки происходит лишь уменьшение коэффициентов стоячих волн с сохранением резонансов

на тех же частотах, что и для случая, когда сфера находится в геометрическом центре поперечного сечения волновода. Кривая 3 рис. 1 соответствует случаю, когда сфера находится посередине узкой стенки волновода. Таким образом, широкая стенка волновода усиливает отражение электромагнитной волны от диэлектрической сферы, а узкая — ослабляет.

Начальное положение диэлектрического эллипсоида вращения в волноводе характеризуется значениями: x = 0, y = 0.  $\Theta = 0^{\circ}$ ,  $\varphi = 0^{\circ}$ . Здесь x, y — координаты геометрического центра эллипсоида вращения,  $\Theta$  — угол между большой осью эллипсоида и продольной осью z волновода ( $\Theta$ ,  $\varphi$  — эйлеровские углы прецессии и нутации соответственно). Начало системы координат совпадает с геометрическим центром поперечного сечения волновода. Основной резонанс для диэлектрического эллипсоида вращения с ориентацией в волноводе x = 0, y = 0,  $\Theta = 0^{\circ}$ ,  $\varphi = 0^{\circ}$  проявляется на длине волны  $\lambda_1 = 33,40$  мм. Кроме этого, в исследуемом диапазоне наблюдаются четко выраженные резонансы на длинах волн:  $\lambda_2 = 30,90$  мм,  $\gamma_3 = 35,30$  мм,  $\gamma_4 = 37,90$  мм. Коэффициенты стоячих волн, измеренные по методике, применяемой для измерения больших КСВ составляли соответственно на этих длинах волн:  $r_1 = 9,70$ ;  $r_2 = 4,81$ ;  $r_3 = 2,05$ ;  $r_4 = 3,32$ .

По мере приближения эллипсоида к широкой стенке волновода растут коэффициенты стоячих волн на всех частотах. Когда эллипсоид касается широкой стенки волновода, все резонансы увеличиваются по амплитуде и составляют соответственно  $r'_1 = 10,80$ ;  $r'_2 = 7,75$ ;  $r'_3 = 3,13$ ;  $r'_4 = 4,00$ . Затем основной резонанс смещается с длины волны  $\lambda_1 = 33,40$  мм на длину волны  $\lambda'_1 = 33,80$  мм. Смещается также и резонанс с длины волны  $\lambda_2 = 30,90$  мм на длину волны  $\lambda'_2 = 31,38$  мм. Коэффициенты стоячих волн в резонансной области между этими длинами волн увеличиваются до уровня 4—5, тогда как для эллипсоида, расположенного в геометрическом центре поперечного сечения волновода, коэффициенты стоячих воли составляли лишь 2—2,5. Структура кривой в резонансной области между длинами волн  $\gamma'_2 = 31,38$  мм и  $\lambda'_1 = 33,80$  мм становится более сложной. Таким образом, широкая стенка волновода усиливает отражение и от диэлектрического эллипсоида, когда последний касается ее.

На рис. 2 приведены зависимости коэффициентов стоячих волн от длины рассеиваемой электромагнитной волны для диэлектрического эллипсоида вращения с такой же начальной ориентацией, что и в предыдущем случае, но теперь эллипсоид перемещался по оси x, т. е. вдоль широкой стенки волновода. Здесь мы встречаемся с интересным случаем, когда эллипсоид касается узкой стенки волновода (кривая 2). При этом сужается резонансная полоса. Резонансы на длинах волн  $\lambda_1 = 33,40$  мм и  $\lambda_2 = 30,90$  мм (кривая 1) сдвигаются, и получается как бы расщепленный резонанс магнитного типа второго порядка, как и для диэлектрической сферы диаметром 5 мм, помещенной в геометрический центр поперечного сечения волновода. Все резонансы по мере приближения к узкой стенке уменьшаются по амплитуде. Эллипсоид ведет себя в этом случае как сфера. Объяснить это можно, опять-таки, пользуясь аналогией с искусственным диэлектриком.

Действительно, если рассмотреть диэлектрик, образованный сферой, расположенной на узкой стенке волновода, и ее отражениями в стенках, а также искусственный диэлектрик, образованный



Рис. 2. Зависимость коэффициентов стоячих волн от длины рассеиваемой электромагнитной волны для диэлектрического эллипсоида вращения: положение эллипсоида:  $\theta = 0^{\circ}, \varphi = 0^{\circ}, \mu = 0, x = 0$  (кривая /); (x = 9 мм (кривая 2),

эллипсоидом вращения с ориентацией как в нашем случае, то легко заметить, что пространственные решетки для них одинаковы. А так как сфера и эллипсоид находятся в минимуме электрического поля, то, очевидно, и следует ожидать проявления одинаковых свойств таких искусственных диэлектриков. Но поскольку сами рассеивающие тела отличаются геометрией, это проявляется в некотором небольшом смещении резонансных частот и возникновении малых дополнительных резонансных пиков в области основного резонанса. Для случаев, когда сфера и эллипсоид находятся на широкой стенке в пучности электрического поля, пространственные решетки таких искусственных диэлектриков совпадают, однако влияние геометрии самих рассеивающих тел проявляется в гораздо большей степени.

Рассмотрим случай, когда диэлектрический эллипсоид вращения ориентирован в волноводе так, что  $\Theta = 90^\circ$ ,  $\varphi = 0^\circ$ . При расположении эллипсоида с такой ориентацией в геометрическом центре

поперечного сечения волновода основной резонанс смещается с длины волны  $\lambda_1 = 33,40$  мм на длину волны  $\lambda_1'' = 32,20$  мм. Резонанс на длине волны  $\lambda_4 = 37,90$  мм исчезает, а резонанс на длине волны  $\lambda_2 = 30,90$  мм лишь уменьшается по амплитуде. Резонансная область между длинами волн  $\gamma_2 = 30,90$  мм и  $\lambda_1'' = 32,20$  мм (кривая 1, рис. 3) становится гораздо уже по сравнению с тем случаем, когда эллипсоид ориентирован так, что  $\Theta = 0^\circ$ ,  $\varphi = 0^\circ$ .



Рис. 3. Зависимость коэффициентов стоячих волн от длины рассеиваемой электромагнитной волны для диэлектрического эллипсоида вращения: положение эллипсоида: ⊕ = 90°, φ = 0°, x = 0, y = 0 (кривая 1); y = 2,50 мм (кривая 2).

При перемещении эллипсоида к широкой стенке волновода вдоль оси у опять-таки наблюдается увеличение коэффициентов стоячих волн. Характерным для этой позиции является расщепление основного резонанса, когда эллипсоид находится посередине широкой стенки волновода (кривая 2, рис. 3).

Перемещение эллипсоида вращения вдоль оси *х* характеризуется возникновением резонансов по мере приближения к узкой стенке волновода на длинах волн  $\lambda = 33$  мм и  $\lambda = 37,70$  мм. При этом, когда эллипсоид касается узкой стенки волновода, резонанс на длине волны  $\lambda = 33$  мм становится расщепленным. Размещение эллипсонда на узкой стенке приводит к уменьшению коэффициентов стоячих волн. Амплитуда основного резонанса уменьшается до величины r = 3,74. Уменьшается по амплитуде и резонанс на длине волны  $\gamma_2 = 30,90$  мм r = 2,37.

Было проведено исследование для случая, когда диэлектрический эллипсоид вращения накоротко замыкает волновод по электрическому полю, т. е. ориентация эллипсоида в волноводе такова, что y = 0,  $\Theta = 0^{\circ}$ ,  $\varphi = 90^{\circ}$ . Перемещение эллипсоида в этом случае возможно лишь в направлении оси *x*. Для x = 0характерно значительное увеличение КСВ по всему диапазону с рядом узких полос прозрачности. Коэффициенты стоячих волн в полосах прозрачности достигают величин порядка 1,10—1,20. Касание узкой стенки волновода с такой ориентацией приводит к уменьшению КСВ и выделению ряда резонансов.

Для изучения влияния геометрии волновода на дисперсионные

свойства рассеяния электромагнитных волн рассеивающие тела (сфера, эллипсоид) помещались в волновод сечением 12.6 × × 28.5 мм. В таблице приведены результаты измерений для диэлектрической сферы, расположенной геометрическом В поперечного сечения центре волноводов  $10 \times 23$  мм и  $12.6 \times$ × 28,5 мм. Следует заметить, что для одних и тех же частот КСВ или лиэлектрической резонансной сферы, расположенной в волноводе 10 × 23 мм. всегда по величине больше, чем КСВ для аналогичного расположения сферы в волноводе 12.6 × 28.5 мм. Лишь в области резонанса такое утверждение

Длина волны, мм	КСВ	
	волновод 10×23 мм	волновод 12,6× ×28,5 мм
29,00 30,00 31,00 31,50 31,55 31,65 31,65 31,75 31,85 31,95 32,00 32,25 32,50 33,00 35,00 37,00	1,952,202,505,8012,006,004,051,804,002,751,501,101,251,451,751,75	1,60 1,70 1,85 2,75 3,00 3,40 6,50 1,75 3,10 6,75 2,60 1,25 1,03 1,25 1,40 1,35

может быть несправедливым, если резонанс расщеплен.

Из таблицы видно, что для сферы, расположенной в волноводе  $12,6 \times 28,5$  мм, обе амплитуды расщепленного резонанса примерно одинаковы по величине. Для сферы же, расположенной в волноводе  $10 \times 23$  мм, одна из амплитуд расщепленного резонанса превышает другую в три раза. Последняя оказывается меньшей по величине, чем соответствующая амплитуда расщепленного резонанса для сферы, расположенной в волноводе  $12,6 \times 28,5$  мм. Кроме этого, резонансные длины волн для волновода  $10 \times 23$  мм несколько смещены в сторону укорочения длины волны по сравнению с волноводом  $12,6 \times 28,5$  мм.

Исследовалось также рассеяние электромагнитной волны на диэлектрической сфере, расположенной посередине широкой стенки волноводов  $10 \times 23$  мм и  $12,6 \times 28,5$  мм. Сравнение показывает, что для сферы, расположенной посередине волновода  $12,6 \times 28,5$  мм, исчезают расщепления резонансов, которые имеют место для такого же расположения сферы в волноводе  $10 \times 23$  мм.

Аналогичные исследования проводились и для диэлектрического эллипсоида вращения. Так, для эллипсоида с ориентацией  $\Theta = 0^\circ$ ,

 $\varphi = 0^{\circ}$ , расположенного в геометрическом центре поперечного сечения волноводов, основной резонанс для волновода 12,6 × 28,5 мм становится расщепленным. Коэффициенты стоячих волн по величине для диэлектрического эллипсоида вращения, расположенного в волноводе 10 × 23 мм, на одних и тех же длинах волн больше, чем для эллипсоида, расположенного в волноводе 12,6 × 28,5 мм. Размещение эллипсоида с ориентацией  $\Theta = 0^{\circ}$ ,  $\varphi = 90^{\circ}$  в волноводе



Рис. 4. Зависимость коэффициентов стоячих волн от длины рассеиваемой электромагнитной волны для диэлектрического эллипсоида вращения, расположенного в волноводе 12,6×28,5 мм; положение эллипсоида  $\theta = 0^{\circ}, \varphi = 90^{\circ}, x = 0, y = 0.$ 

 $12,6 \times 28,5$  мм приводит к изменению характера резонансной кривой по сравнению с аналогичным расположением эллипсоида в волноводе  $10 \times 23$  мм (рис. 4).

Таким образом, изменение геометрии волновода также обусловливает изменение резонансных кривых, что проявляется в изменении амплитуд резонансов, некотором смещении резонансной области, в исчезновении или возникновении расщепления резонансов и даже в изменении характера резонансной кривой (например, случай, когда длэлекгрический эллипсоид вращения орнентирован в волноводах так, что его большая ось совпадает с направлением электрического поля, т. е. y = 0,  $\Theta = 0^{\circ}$ ,  $\varphi = 90^{\circ}$ ).

Анализ погрешностей показывает, что среднеквадратичная ошибка измерений коэффициентов стоячих волн в области резонансов и больших КСВ составляет ± 4,5%, а в области небольших КСВ. вдали от резонансов, не превышает ± 1,5%.

## выводы

1. Анизотропию рассеяния и дисперсию коэффициента отражения в резонансной области можно усиливать или ослаблять изменением положения диэлектрической резонансной неоднородности в сечении волновода.

2. Максимальное отражение и расширение резонансной полосы наблюдается, когда рассеивающая диэлектрическая сфера находится на широкой стенке волновода, минимальное — при размещении рассеивающего тела на узкой стенке.

 Размещение диэлектрической сферы на широкой стенке волновода приводит к расширению резонансной полосы так же, как и вращение эллипсоида, расположенного в геометрическом центре поперечного сечения волновода, вокруг осей волновода.

4. Изменение геометрии самого рассеивающего тела вызывает изменение резонансной полосы при размещении диэлектрической резонансной неоднородности в геометрическом центре поперечного сечения волновода.

5. Изменение геометрии волновода ведет к усилению или ослаблению дисперсионных свойств рассеяния эмектромагнитной волны на диэлектрической резонансной неоднородности и к изменению характера резонансной кривой.

## ЛИТЕРАТУРА

1. А. И. Козарь, Н. А. Хижнях. УФЖ, 15, 5, 1970.

2. А. И. Козарь, Н. А. Хижняк. Сб. «Радиотехника», вып. 14. Изд-во ХГУ, Харьков, 1970.

3. М. І. Українець, М. А. Хижняк. «Вісник Харківського університету. Радіофізика і електроніка», вип. 1. Изд-во ХГУ, Харьков, 1972.
4. Н. А. Хижняк. ЖТФ, 27, 1957.